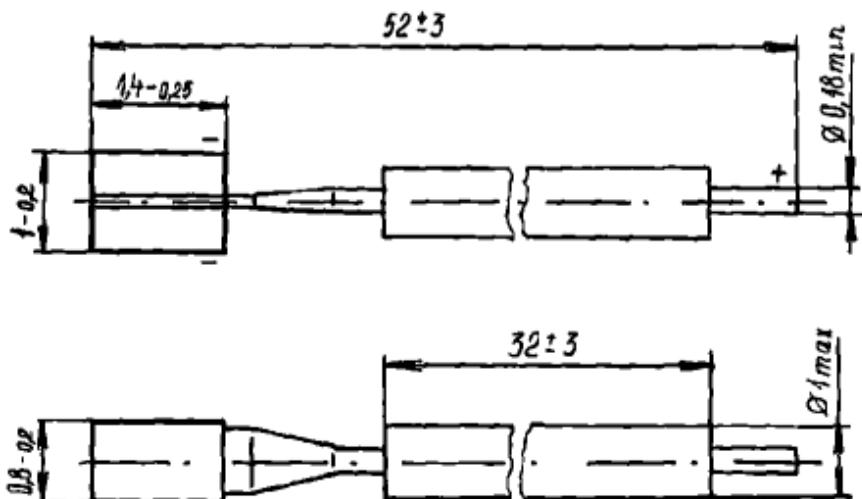


ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СВЧ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ

2A505A—2A505B

Диоды 2A505A, 2A505Б, 2A505B полупроводниковые сверхвысокочастотные, переключательные, кремниевые, сплавные бескорпусные предназначены для работы в переключателях, модуляторах, фазовращателях, аттенюаторах сантиметрового и дециметрового диапазона длин волн в изделиях радиоэлектронной аппаратуры.



Масса не более 0,05 г

Пример записи условного обозначения при заказе и в конструкторской документации:

Диод СВЧ 2A505A ТРЗ.360.065 ТУ

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц 5—2500

амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) 150 (15)

Механический удар:

одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) 5000 (500)

многократного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) 1500 (150)

длительность действия, мс 1—80

Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) 1500 (150)

Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст) 666 (5)

Атмосферное повышенное давление, Па (kgs/cm^2) 297 198 (3)

Повышенная рабочая температура среды, °C

125

2A505A—2A505B

ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СВЧ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ

Пониженная рабочая температура среды, °С.....	минус 60
Изменение температуры среды, °С.....	от минус 60 до +125
Повышенная относительная влажность при 40 °С, %....	98

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрические параметры

Потери пропускания ($P_{пд} \geq 1$ мВт), дБ, не более:

2A505A, 2A505Б	0,25
2A505Б	0,40

Потери запирания ($I_{пр}=100$ мА, $P_{пд} \geq 1$ мВт), дБ, не менее:

2A505A, 2A505Б	21
2A505Б	25

Время установления прямого сопротивления ($I_{пр}=100$ мА, $P_{пд} \geq 1$ мВт), мкс, не более.....

6

Время восстановления сопротивления ($P_{пд} \geq 1$ мВт), мкс, не более.....

60

Предельно допустимые значения электрических параметров режимов эксплуатации

Максимально допустимая рассеиваемая мощность, Вт.....

2

Максимально допустимая импульсная падающая СВЧ мощность в линии с волновым сопротивлением 250 Ом при длительности воздействия 1 мкс и скважности 500, кВт, не более:

диод при токе прямого смещения равном 0:

в Н - образном волноводе и полосковых линиях.....	5
в резонансной щели.....	2

диод при токе прямого смещения равном 100 мА.....

100

Нормируемое обратное напряжение, В, не более.....

минус 100

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка, ч

2000

Минимальный срок сохраняемости, лет.....

12

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется принимать меры, исключающие повреждение диодов от воздействия разрядов статического электричества, токов утечки от постоянных источников напряжения и прочих токов.

Пайку электродов производить с принятием мер, исключающих повреждение диодов из-за перегрева и механических усилий.

Пайку и облучивание диодов производить припоеем ПОС-61 или ПОСК-50-18.

Флюс спирто - канифольный: 15%-канифоль, 85%-спирт.

При монтаже диодов в схему не допускается наличие следов припоя и флюса на боковых поверхностях диодов.

Пайку диодов при монтаже их в схему производить при температуре 180—200 °С для припоя ПОС61 или не более 170 °С для припоя ПОСК-50-18.

При установке диодов в аппаратуру учитывать, что категорически воспрещается перегибать вывод на расстоянии менее 5 мм от основания и прикладывать растягивающее усилие к выводу более 100 г.

При включении диода в линию с волновым сопротивлением, отличным от 250 Ом, допустимая импульсная СВЧ мощность определяется по формуле:

$$P_{\text{доп}} = \frac{250}{W} P_i$$

где W — волновое сопротивление.

Допускается двух - трехкратная перепайка диодов при монтаже их в схему.

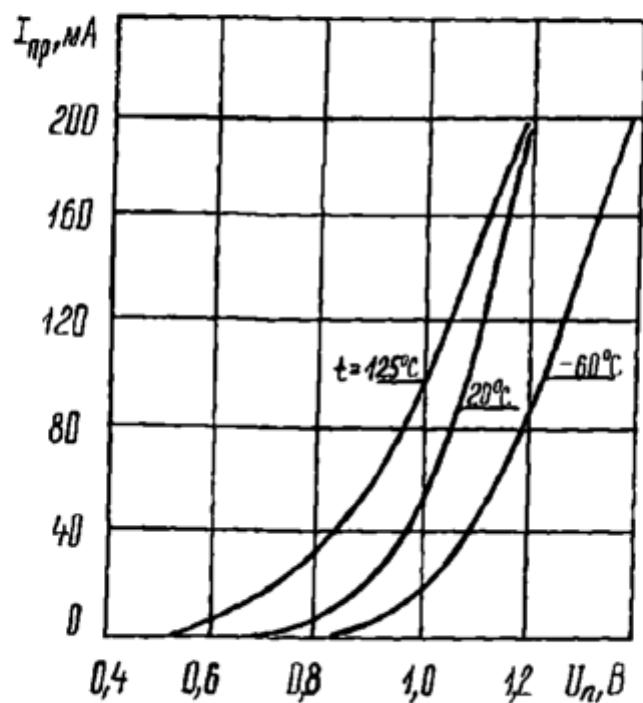
Допустимое значение статического потенциала 2000 В.

2A505A—2A505B

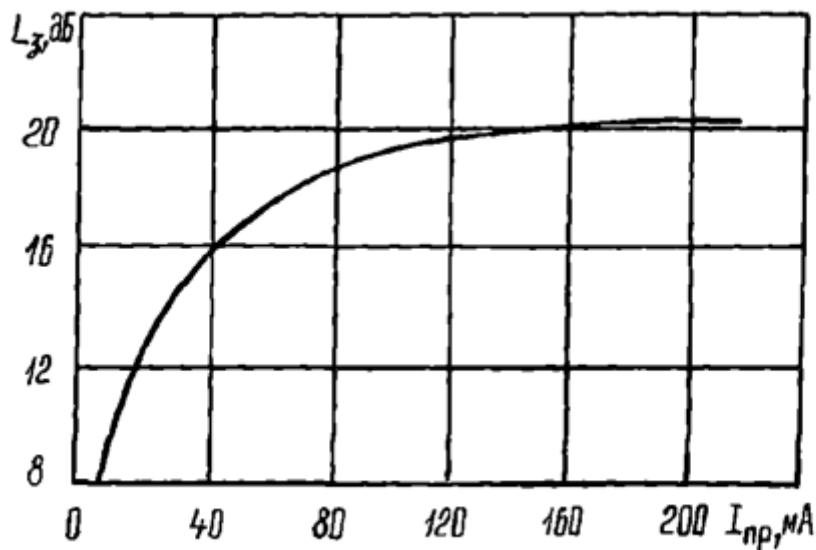
**ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СВЧ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ**

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

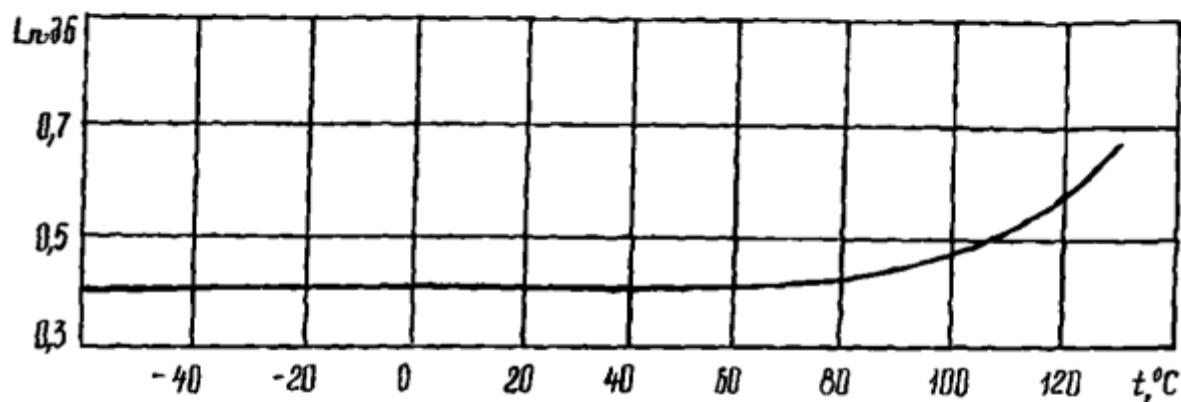
Прямые ветви вольт-амперной характеристики



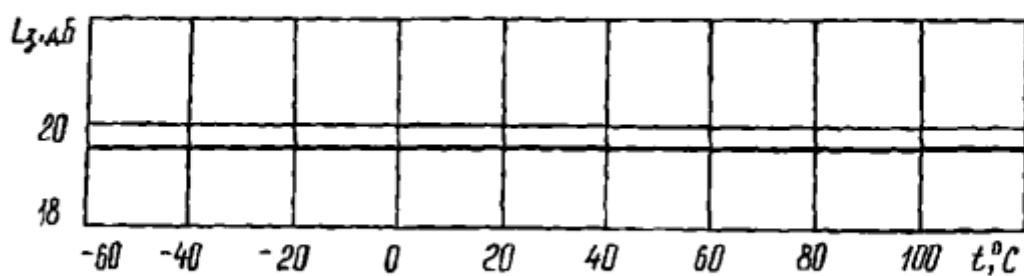
Характеристика потерь запирания в зависимости от прямого тока



Характеристика потерь пропускания в зависимости от температуры среды



Характеристика потерь запирания в зависимости от температуры среды



Характеристика потерь пропускания в зависимости от импульсной СВЧ мощности

